C バンドにおける損失補償特性を持つ InP 系 VCSEL 分波器 InP VCSEL Demultiplexer with Loss Compensation in Full C-band 東工大未来研¹, 東工大技術部² ○冨樫 良介¹, 顧 暁冬¹, 松谷晃宏², 坂口孝浩¹, 小山二三夫¹

Tokyo Tech. FIRST¹, Tokyo Tech. Technical Dept.² ^OR. Togashi¹, X. Gu¹, A. Matsutani², T. Sakaguchi¹ and F. Koyama¹

E-mail: togashi.r.ab@m.titech.ac.jp

1. はじめに

昨今, インターネットトラフィックは複雑化しており, 波長選択スイッチ(WSS)の光通信における制御機能が学術 的および産業的注目を受けている[1]. 分波器は WSS モジ ュールの性能を決定づける重要な素子であり、

我々のグル ープは高い角度分散などの優れた特性を持つ VCSEL ベー スの分波器を提案してきた[2]. 本報告は, InP 系 VCSEL 構 造に基づくブラッグ反射鏡導波路を用いたアクティブ型 分波器の C バンド全域での動作について示すものである. デバイス構造と動作原理 2.

Fig. 1(a), (b)に製作したデバイスの概要図と写真を示す. InP 基盤に下部 DBR, 活性層, トンネル接合をエピタキシ ャル成長させたウエハに電極と誘電体ミラーを蒸着し、ド ライエッチングによってメサを形成した. また, トンネル 接合にイオン注入を行うことで電流狭窄用のアパチャを 形成した. 先球ファイバから結合した光は DBR の多重反 射によりスローライトとして伝搬し、その一部が上部ミラ ーから放射される[3]. その際の偏向角は導波路の構造分散 による波長依存性を持ち,この原理で波長分波を行う. 3.

測定結果

Fig.2 は素子長 1mm のデバイスに光を結合し、電流注入 を行った際の NFP である. 伝搬距離の増加を確認でき, 出 力の増加と高品質化を期待できる.

Fig. 3 は C バンドの中心波長である 1550nm の光結合と 電流注入を行ったときの FFP のプロファイルの変化を示 しており,出力光の増強と狭窄を確認できる(角度分解能は 0.5°から0.3°へ狭窄). Fig. 4 に C バンド全域における偏向 角と角度分解能を示す.全帯域で偏向角の変化があり、C バンド全域において分波特性を持つことが分かる.角度分 散は 0.52[deg./nm]であり、1560nm 以上を除く帯域におい ては電流注入による角度分解能の向上を確認できる.

次に, Fig. 5 中の概念図の通り, 光結合と電流注入を行 い, PD で強度を測定した. 波長 1545nm, パワー142mWの 外部光を注入した.フォトカレントから計算した結合光の パワーは 28.5mW であり、電流注入前の出力は 13.0mW で あった. CW 駆動とパルス駆動でそれぞれ 300mA と 700mA の電流注入を行い,20.0mWと25.1mWの出力を確認した. それぞれのデバイス挿入損失は 1.5dB と 0.5dB となる. Fig. 6 はコア直径62.5μmの MMF から出力光を取り込んだ際の スペクトルであり, 200mA の電流注入時においても出力光 がシングルモードであることと、3dBほどの増幅を確認で きる.

参考文献

- [1] D. M. Marom et al, J. Lightwave Tech., 23, p. 1620 (2005).
- [2] X. Gu et al, J. Lightwave Tech., 33 (7) p. 1358 (2015)
- [3] X. Gu et al, Optics Express Vol.19, Issue 23, pp.22675-22683, 2011.

謝辞

本研究の一部は, 華為技術日本株式会社の助成を受けました. 深 く感謝します.



Fig. 1 (a) Schematic of slow-light demultiplexer and (b) picture of fabricated devices.



Fig. 2 Near-field pattern observations with different current injections.

